



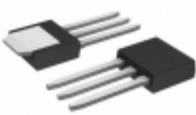

| | |
|---|---|
|  | <p>SIHU7N60E-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIHU7N60E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> <p>Datenblätter:  SIHU7N60E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIHU7N60E-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 7A TO-251 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | I-Pak |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 600 mOhm @ 3.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 78W (Tc) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 680pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7A (Tc) |

SIHU7N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU7N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU7N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHU7N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SIHW23N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p> |  <p>SIHU6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p> |  <p>SIHU7N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> |  <p>SIHW23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A TO-247AD</p> |
|  <p>SIHU7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-251</p> |  <p>SIHU6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p> |  <p>SIHU6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p> |  <p>SIHW30N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO-247AD</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| SIHU7N60E-GE3 Vishay / Siliconix | SIHU7N60E-GE3 Datenblatt | SIHU7N60E-GE3-Datenblätter | SIHU7N60E-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SIHU7N60E-GE3 |
| SIHU7N60E-GE3 Electronic | SIHU7N60E-GE3-Komponenten | SIHU7N60E-GE3-Verteiler | SIHU7N60E-GE3-Bild | SIHU7N60E-GE3-Teil |
| SIHU7N60E-GE3 Preis | SIHU7N60E-GE3 Hersteller | SIHU7N60E-GE3 Bild | SIHU7N60E-GE3 Aktie | SIHU7N60E-GE3 Inventar |
| SIHU7N60E-GE3 Neu | SIHU7N60E-GE3 Original | SIHU7N60E-GE3 garantiert | SIHU7N60E-GE3 RFQ | SIHU7N60E-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited